

SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR

FMMT451

ISSUE 3 - OCTOBER 1995

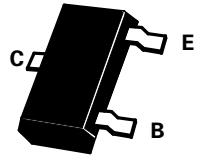


FEATURES

- * Low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)} 400m\Omega$ at 1A
- * 1 Amp continuous current
- * $P_{tot} = 500$ mW

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT551

PARTMARKING DETAIL – 451



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

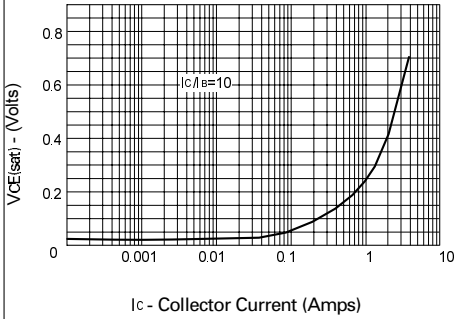
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	1	A
Base Current	I_B	200	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$).

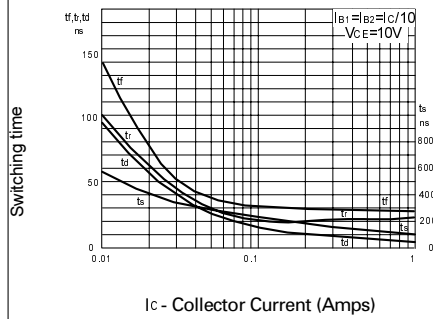
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	80		V	$I_C = 100\mu A$
Collector-Emitter Sustaining Voltage	$V_{CEO(sus)}$	60		V	$I_C = 10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E = 100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.1	μA	$V_{CB} = 60V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.1	μA	$V_{EB} = 4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.35	V	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.1	V	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	50 10	150		$I_C = 150mA, V_{CE} = 10V^*$ $I_C = 1A, V_{CE} = 10V^*$
Transition Frequency	f_T	150		MHz	$I_C = 50mA, V_{CE} = 10V$ $f = 100MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		15	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

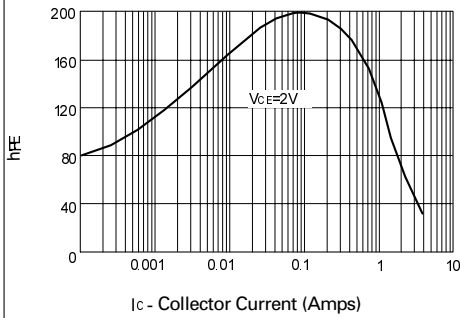
TYPICAL CHARACTERISTICS



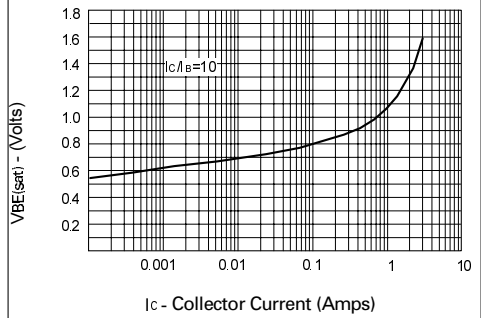
$V_{CE(sat)}$ v I_C



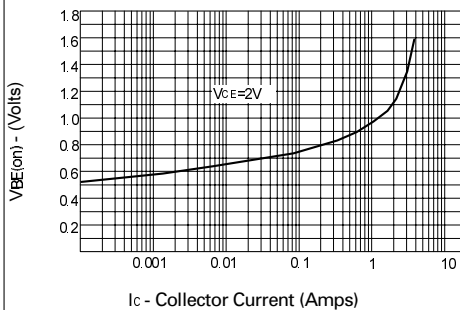
Switching Speeds



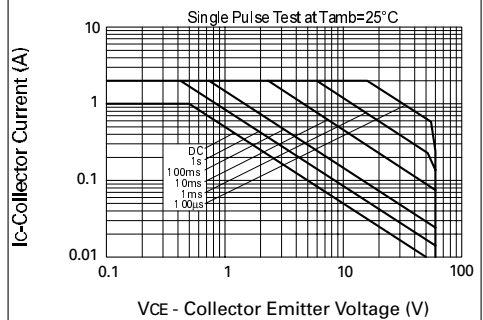
h_{FE} v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Safe Operating Area

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9